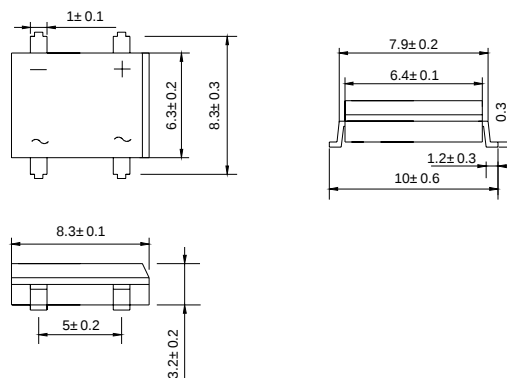




## Features

- ◇ Rating to 400 VPRV
- ◇ Surge overload rating to 30 Amperes peak
- ◇ Ideal for printed circuit board
- ◇ Reliable low cost construction utilizing molded
- ◇ Lead solderable per MIL-STD-202 method 208
- ◇ Lead: silver plated copper, solderde plated
- ◇ Plastic material has UL flammability classification 94V-O
- ◇ Polarity symbols molded on body
- ◇ Weight: 1.0 grams

## DB-S



Dimensions in millimeters

## MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.

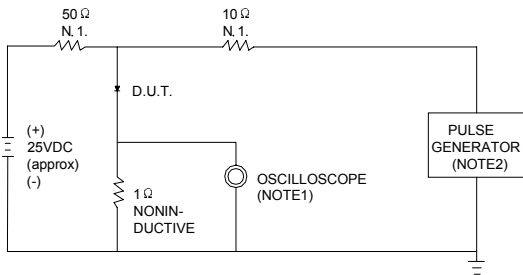
Single phase, half wave, 60 Hz, resistive or inductive load. For capacitive load, derate by 20%.

|                                                                                                      |                    | EDB<br>101S     | EDB<br>102S | EDB<br>103S | EDB<br>104S | EDB<br>105S | EDB<br>106S | UNITS    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| Maximum recurrent peak reverse voltage                                                               | V <sub>RRM</sub>   | 50              | 100         | 150         | 200         | 300         | 400         | V        |
| Maximum RMS voltage                                                                                  | V <sub>RMS</sub>   | 35              | 70          | 105         | 140         | 210         | 280         | V        |
| Maximum DC blocking voltage                                                                          | V <sub>DC</sub>    | 50              | 100         | 150         | 200         | 300         | 400         | V        |
| Maximum average forw ard<br>Output current @T <sub>A</sub> =55°C                                     | I <sub>F(AV)</sub> | 1.0             |             |             |             |             |             | A        |
| Peak forw ard surge current<br>8.3ms single half-sine-w ave<br>superimposed on rated load            | I <sub>FSM</sub>   | 30.0            |             |             |             |             |             | A        |
| Maximum instantaneous forw ard voltage<br>at 1.0 A                                                   | V <sub>F</sub>     | 1.0             |             |             |             |             |             | V        |
| Maximum reverse current @T <sub>A</sub> =25°C<br>at rated DC blocking voltage @T <sub>A</sub> =100°C | I <sub>R</sub>     | 10.0<br>1.0     |             |             |             |             |             | µA<br>mA |
| Maximum reverse recovery time (NOTE 1)                                                               | t <sub>rr</sub>    | 50              |             |             |             |             |             | nS       |
| Typical junction calacitance (NOTE 2)                                                                | C <sub>J</sub>     | 15              |             |             |             | 10          |             | pF       |
| Operating junction temperature range                                                                 | T <sub>J</sub>     | - 55 ---- + 150 |             |             |             |             |             | °C       |
| Storage temperature range                                                                            | T <sub>STG</sub>   | - 55 ---- + 150 |             |             |             |             |             | °C       |

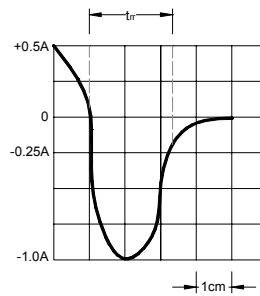
NOTE: 1. Test conditions:  $I_F=0.5\text{A}$ ,  $I_R=1.0\text{A}$ ,  $I_{RR}=0.25\text{A}$ .

2. Measured at 1 MHz and applied reverse voltage of 4.0 volts.

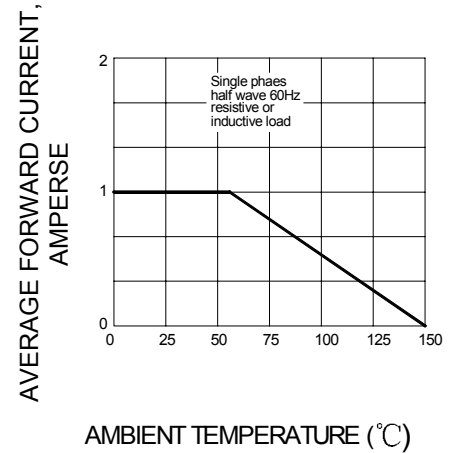
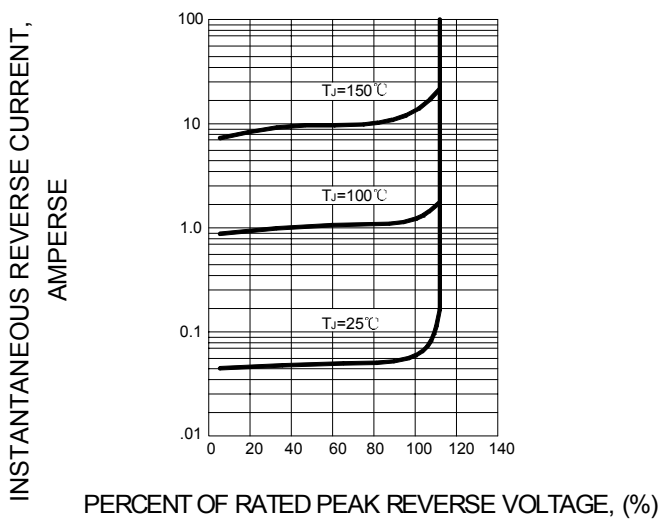
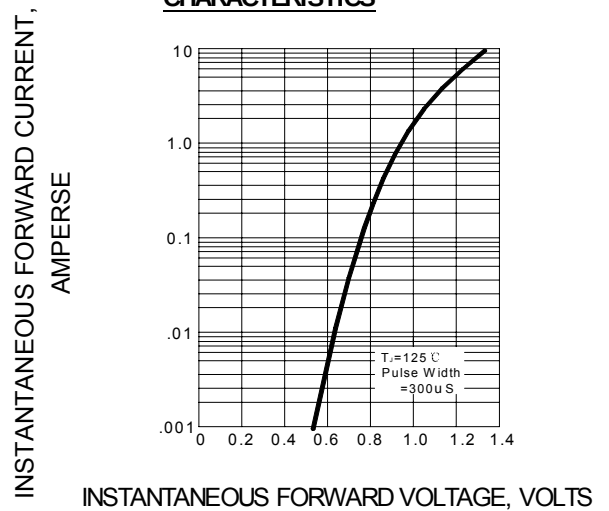
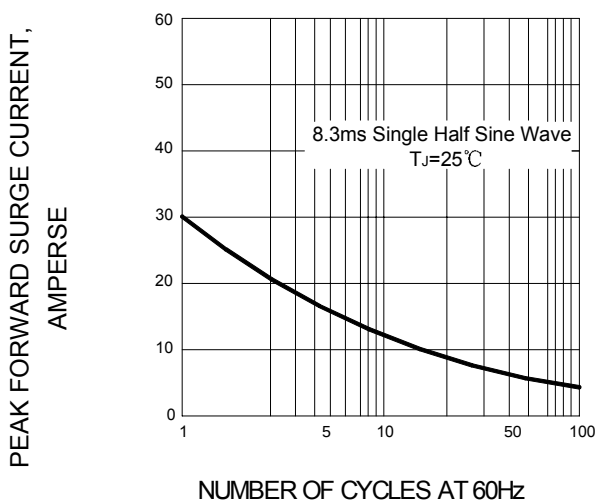
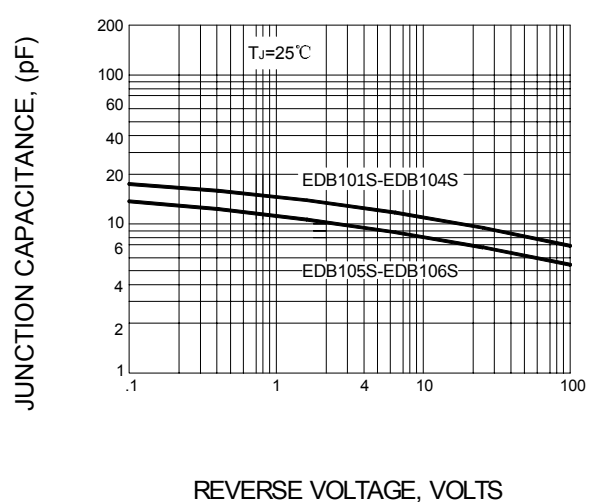
## Ratings AND Characteristic Curves

**FIG.1 -- TEST CIRCUIT DIAGRAM AND REVERSE RECOVERY TIME CHARACTERISTIC**


NOTES: 1. RISE TIME = 7ns MAX. INPUT IMPEDANCE = 1MΩ 22pF  
2. RISE TIME = 10ns MAX. SOURCE IMPEDANCE = 50Ω



SET TIME BASE FOR  
10 ns / cm

**FIG.2 -- TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE**

**FIG.3 -- TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS**

**FIG.4 -- TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD CHARACTERISTICS**

**FIG.5 -- MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD SURGE CURRENT**

**FIG.6 -- TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE**


## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9